



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	双金属栅极CMOS器件及其制造方法
专利类别:	国际专利
申请号:	PCT/CN2012/075685
申请日期:	2012-05-17
专利号:	9,384,986
第一发明人:	殷华湘;付作振;徐秋霞;陈大鹏
实施情况:	授权
专利证书号:	9,384,986
其它备注:	十室

